

2SA682

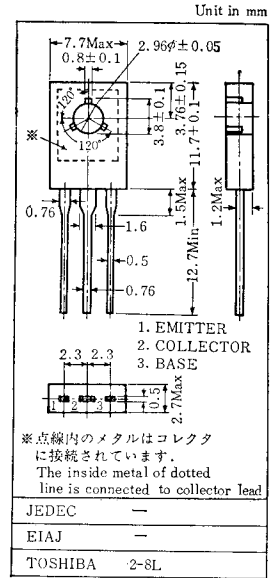
シリコンPNPエピタキシャル形トランジスタ (PCT方式) SILICON PNP EPITAXIAL TRANSISTOR (PCT PROCESS)

- 中電力増幅用 ○励振段増幅用
- Medium Power Amplifier Applications
- Driver Stage Amplifier Applications

- 高耐圧です: $V_{CE0} = -80V$
- 高出力 Hi-Fi Amp. の励振段に適します。
- 2SC1382のコンプリメンタリになります。
- Complementary to 2SC1382

最大定格 MAXIMUM RATINGS ($T_a = 25^\circ C$)

Characteristic	Symbol	Rating	Unit
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	-80	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	-80	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	-5	V
コレクタ電流	I_C	-750	mA
エミッタ電流	I_E	750	mA
コレクタ損失	P_C	800	mW
接合温度	T_J	150	$^\circ C$
保存温度	T_{stg}	-65~150	$^\circ C$



アクセサリはAC46Cを適用
MOUNTING KIT NO AC46C

電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a = 25^\circ C$)

Characteristic	Symbol	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = -30V, I_E = 0$	—	—	-0.1	μA
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = -5V, I_C = 0$	—	—	-1.0	μA
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C = -10mA, I_B = 0$	80	—	—	V
エミッタ・ベース間降伏電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E = 0.1mA, I_C = 0$	5	—	—	V
直流電流増幅率	(Note) $h_{FE(1)}$	$V_{CE} = -2V, I_C = -150mA$	70	—	240	
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE} = -2V, I_C = -500mA$	40	—	—	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -500mA, I_B = -50mA$	—	—	-0.5	V
ベース・エミッタ間電圧	V_{BE}	$V_{CE} = -2V, I_C = -500mA$	—	—	-1.0	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CE} = -2V, I_C = -150mA$	50	100	—	MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB} = -10V, I_E = 0, f = 1MHz$	—	15	—	pF

Note ; $h_{FE(1)}$ により下表のように分類し、現品表示してあります。

According to the value of $h_{FE(1)}$, the 2SA682 is Classified as follows.

Classification	Min.	Max.
2SA682—O	70	140
2SA682—Y	120	240

